(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-160355

(43)公開日 平成11年(1999)6月18日

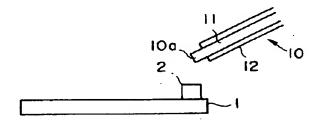
(51) Int.Cl. ⁵ G 0 1 R 1/067 1/073		饑別記号	F I G O 1 R 1 1		G D		
	1/66		H01L 21	1/66]	В .	
			審査請求	未請求	請求項の数4	OL	(全 6 頁)
(21)出願番号		特顧平9-329245	(71)出願人	000006264 三菱マテリアル株式会社			
(22)出願日		平成9年(1997)11月28日	(72)発明者	東京都千代田区大手町1丁目5番1号 加藤 直樹 兵庫県三田市テクノパーク十二番の六 三 菱マテリアル株式会社三田工場内			
			(72)発明者	佐々木	第人		

(54) 【発明の名称】 コンタクトプロープ

(57)【要約】

【課題】 コンタクトビンの通電用接触部に端子の金属が付着してショートするのを防ぐ。

【解決手段】 コンタクトプローブ30のコンタクトピン10は、Ni-Mn合金からなる内部層11の先端部10aを露出させて、その他の表面をAuの第一被覆層12で被覆する。



兵庫県三田市テクノパーク十二番の六 三 菱マテリアル株式会社三田工場内

兵庫県三田市テクノパーク十二番の六 三

(外11名)

最終頁に続く

菱マテリアル株式会社三田工場内

(72)発明者 吉田 秀昭

(74)代理人 弁理士 志賀 正武

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のバターン配線がフィルム上に形成 され、これらのパターン配線の各先端が前記フィルムか ち突出してコンタクトピンとされるコンタクトプローブ において、前記コンタクトピンの針先は、N i 基合金か らなる内部層が、通電用接触部を除いて導電性金属で被 覆されていることを特徴とするコンタクトプローブ。

【請求項2】 複数のパターン配線がフィルム上に形成 され、これらのパターン配線の各先端が前記フィルムか において、前記コンタクトピンの針先は、N i 基合金か ちなる内部層が白金族の金属で被覆されていることを特 徴とするコンタクトプローブ。

【請求項3】 前記白金族の金属の表面は、通電用接触 部を除いて導電性金属で被覆されていることを特徴とす る請求項2記載のコンタクトプローブ。

【請求項4】 複数のパターン配線がフィルム上に形成 され、これらのパターン配線の各先端が前記フィルムか ち突出してコンタクトピンとされるコンタクトプローブ において、前記コンタクトビンの針先は、N i 基合金か 20 らなる内部層のうち、通電用接触部が白金族の金属で被 覆され、その他の部分は導電性金属で被覆されていると とを特徴とするコンタクトプローブ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、ブローブカード等 に組み込まれて、半導体ICチップや液晶デバイス等の 各端子に接触して電気的なテストを行うコンタクトプロ ーブに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、ICチップやLSIチップ等の 半導体チップ、またはLCD(液晶表示体)の各端子に 接触させて電気的なテストを行うために、コンタクトピ ンが備えられたコンタクトプローブが用いられる。例え は、図5及び図6に示すコンタクトブローブ30では、 Cu等の金属層からなるグラウンド31上にポリイミド 樹脂等からなるフィルム層32が積層され、このフィル ム層32上に接着剤からなる接着剤層33を介してNi 基合金等からなるパターン配線34が配列固定されてい る。とのパターン配線34の先端部は狭ビッチで配列さ 40 れてフィルム層32の先端部から突出しており、それぞ れコンタクトピン3を構成する。このコンタクトピン3 の針先に半導体ICチップや液晶デバイス等の端子が接 触させられることになる。

【0003】とのようなコンタクトプローブ30は図7. 及び図8に示すようにメカニカルピースに組み込まれて プローブカード(プローブ装置)36とされ、コンタク トピン3に半導体ICチップ等の端子が接触させられる ことになる。即ち、図7及び図8に示すプローブカード 36において、中央窓部37aを有するブリント基板3 50 らかく、塑性変形しやすく、かつ化学的に非常に安定で

7の上に、例えばトップクランプ38を取り付ける。ま たトップクランプ38の下部にベースクランプ39をボ ルト40等で固定し、コンタクトプローブ30の先端側 部分を両面テープ等でベースクランプ39の下面に取り 付ける。そして略額縁形状のボトムクランプ41でコン タクトプローブ30の基部を押さえつけることにより、 コンタクトプローブ30の先端側部分を傾斜状態に保持 し、基部はボトムクランプ41の押さえゴム42でブリ ント基板37の下面に押しつけられる。これによって、 ら突出してコンタクトピンとされるコンタクトプローブ(10)コンタクトプローブ30のパターン配線34の後端部が 窓部44を通してプリント基板37の下面の端子に押し つけられて接触状態に保持されることになる。このよう な状態で、半導体 I C チップ 1 等の被検査物の端子2 が コンタクトピン3に接触させられて電気的なテストが行 われることになる。

> 【0004】ところで、例えば、図9に示すように、半 導体 I C チップ 1 の端子2 として、金A u やハンダP b - Sn等の金属が用いられているものがある。これに対 して、コンタクトプローブ30のコンタクトピン3は、 テスト用通電時の高周波信号の劣化を防ぐ必要があり、 導電率の良い材質を採用する必要がある。コンタクトビ ン3の材質として通常用いられるNi-Mn合金等は、 硬度は高いが電気抵抗が大きいために、通電時に伝送信 号が劣化してノイズを生じやすく、好ましくない。その ため、図9に示すように、コンタクトピン3はNi-M n合金を用いて内部層4を形成し、その表面をAuを用 いて被覆して被覆層5が形成されている。そして、テス ト時にコンタクトピン3を端子2に接触させると、端子 2とコンタクトピン3間では導電率の良い被覆層5を通 して、信号の伝送がなされることになる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような コンタクトピン3を用いて、半導体ICチップ1等の電 気的テストが繰り返して行われると、コンタクトピン3 の先端に端子2のAuが付着して(これを付着部6とい う)徐々に成長するという現象が起こる。そのため、隣 接する複数のコンタクトピン3、3で、各コンタクトピ ン3の先端に付着して成長した付着部6.6が、図10 に示すように、互いに接触してショートするという問題 を引き起こす。また、端子2の金属として、金以外にハ ンダ等の柔らかい金属を用いた場合にも同様な問題を引 き起とすととになる。

【0006】本発明は、このような実情に鑑みて、コン タクトピンの通電用接触部に端子の金属が付着したりせ ずに、劣化を防いで信号の伝送を行えるようにしたコン タクトプローブを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述の課題に鑑みて、本 発明者らが鋭意研究した結果、Au等のように非常に柔 あるために表面皮膜が形成されにくいという性質を持った金属は、同一の金属間で相互接触すると、低接触力でもA u 等の金属の表面に塑性変形によって新しい面が現れ、この新しい面で接触が行われるために粘着現象が発生することを見いだした。そのため、Au - Au等、同一の導電性の良い金属同士等の接触面では、通電状態だけでなく、通電しない場合でも一方に他方の金属が付着し易いという現象が見られる。本発明はこのような知見に基づくものである。

【0008】本発明に係るコンタクトプローブは、複数 のパターン配線がフィルム上に形成され、これらのパタ ーン配線の各先端がフィルムから突出してコンタクトピ ンとされるコンタクトプローブにおいて、コンタクトピ ンの針先は、N i 基合金からなる内部層が、通電用接触 部を除いて導電性金属で被覆されていることを特徴とす るものである。半導体ICチップなどの被検査物の端子 にコンタクトピンの通電用接触部を接触させると、通電 用接触部はN i 基合金が露出しているために異種金属の 接触となり、しかもNi基合金は硬度が高いために端子 の金属が付着するのを防止できる。しかもコンタクトピ 20 ンは、通電用接触部以外の部分がAu等の導電性金属で 被覆されているから導電性が良く、しかも表皮効果を利 用できるために信号が劣化することなく伝送され、高周 波対応も可能である。尚、ことで導電性金属とは、導電 性の良い、柔らかく、塑性変形しやすい性質を持った金 属をいい、例えばAu、Ag、Cu等が含まれる。

[0009] また本発明に係るコンタクトプローブは、複数のパターン配線がフィルム上に形成され、とれらのパターン配線の各先端がフィルムから突出してコンタクトピンとされるコンタクトプローブにおいて、コンタクトピンの針先は、Ni基合金からなる内部層が白金族の金属で被覆されていることを特徴とする。通電用接触部でNi基合金が露出しないから、この部分の酸化による接触不良が起こらず、しかも白金族の金属は端子と異種金属で硬度が高いので粘着現象を生じない。また、白金族の金属の表面は、通電用接触部を除いて導電性金属で被覆されていてもよい。硬度の高い白金族の金属からなる通電用接触部で端子と接触することで、通電用接触部に粘着現象が生じず、コンタクトピンの内部では、表皮効果でAu等の導電性金属の被覆層を信号が伝送されることになる。

[0010]また本発明に係るコンタクトプローブは、複数のパターン配線がフィルム上に形成され、これらのパターン配線の各先端がフィルムから突出してコンタクトピンとされるコンタクトプローブにおいて、コンタクトピンの針先は、Ni基合金からなる内部層のうち、通電用接触部が白金族の金属で被覆され、その他の部分はAu等の導電性金属で被覆されていることを特徴とする。硬度の高い白金族の金属からなる通電用接触部で端子と接触することで、通電用接触部に粘着現象が生じ

ず、コンタクトビンの内部では、表皮効果でA u 等の導 電性金属の被覆層を信号が伝送されることになる。 【0011】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面により説明するが、上述の従来技術と同一の部分に は同一の符号を用いてその説明を省略する。図1は第一 の実施の形態によるコンタクトピンの針先の縦断面とⅠ Cチップとを示す概略説明図である。図1において、半 導体 I Cチップ 1 の端子2 は少なくとも表面がA u で構 成されている。また、図1で端子2は、1つを除いて省 略されている。図1に示す実施の形態によるコンタクト ピンが装着されるコンタクトプローブはコンタクトピン の部分を除いて上述の従来技術で開示したコンタクトプ ローブ30と同一構成である。図1に示すコンタクトビ ン10において、内部層11は、高い硬度と塑性変形し にくい特性を要求されるために、Ni基合金が用いられ る。Ni基合金として、実施の形態では例えばMnを 0.05~1.5wt%含有したNi-Mn合金が用いら れる。ととで、Mn量が0.05wt%未満では、Hv3 50以上の硬度が得られず高温加熱によって硬度が極端 に低下するおそれがある。また、1. 5 wt%を超えると 先端部の応力が増大してしまい湾曲するおそれがあると ともに非常に脆く靱性が低下してしまうことになる。 尚、Ni基合金として、Ni-Co合金などを用いても よい。

【0012】そして、コンタクトビン10の針先において、内部層11の先端部は外部に露出している(端子2との)通電用接触部であり、これをコンタクトビン10の先端部10aとする。そして、先端部10aを除いた内部層11の表面は、導電性の高いAuで被覆されて第一被覆層12とされる。ここで、内部層11の先端部10a以外の部分をAuで被覆したのは、Ni-Mn合金は電気抵抗が大きいために信号の伝送線路としては損失が大きく、信号が劣化してノイズが発生するためである。他方、高周波信号は一般にコンタクトビン10の表面を流れる特性を有する(表皮効果という)ために、コンタクトビン10の表面を導電性の良いAuで被覆することで、信号の劣化を防止できるためである。

【0013】次に上述した実施の形態によるコンタクト ピン10の製造方法について説明する。コンタクトピン 10を製造する工程は、例えば特公平7-82027号 公報に開示されたものと同様である。即ち、ステンレス 製の支持基板の上にCuめっきによりベースメタル層を形成する。このベースメタル層の上にフォトレジスト層を形成した後、フォトレジスト層に所定のバターンのマスクを施して露光し、フォトレジスト層を現像してコンタクトピンとなる部分を除去して、残存するフォトレジスト層に開口部を形成する。そして、この開口部にコンタクトピン10となるNi基合金層として、Ni-Mn 合金をめっき処理により形成する。ここで、コンタクト

ピン10の先端部10aのみNi-Mn合金の内部層1 1を露出してAuの第一被覆層12で被覆する方法として、製作されたコンタクトピン10の内部層11の先端部10aを予めマスキングしてAuめっきする手法を用いる。或いは、コンタクトピン10の内部層11全体をAuめっきで被覆しておいて、先端部10aのみAuを剥離させる手法を用いてもよく、いずれを用いても良い。

【0014】上述のように本実施の形態によれば、コンタクトピン10を備えたコンタクトプローブを上述の図 107及び8に示すプローブカード36等に装着して、コンタクトピン10の針先を半導体1Cチップ1の端子2に接触させた場合、端子2の材質がAuであるのに対して、これに押圧されて接触するコンタクトピン10の先端部10aが、硬度の高い異種金属であるNi-Mn合金からなるために、先端部10aに端子2のAuが付着することがなく、粘着現象を生じることはない。しかも、端子2から先端部10aに伝送された高周波信号は、コンタクトピン10の表面であるAuで構成される第一被覆層12を流れるために、信号の劣化によるノイ 20ズの発生を最小限に抑えることができる。

【0015】尚、上述の第一の実施の形態によれば上述 の作用効果を奏するが、コンタクトピン10の先端部1 OaにNi-Mn合金の内部層11が露出していること で、Ni-Mn合金が酸化し、そのために結果的に接触 時の電気抵抗が増大し、接触不良が発生することがあ る。次に説明する本発明の第二の実施は、とのような問 題を改善したものであり、とれを図2により説明する。 図2に示すコンタクトピン14は、Ni-Mn合金から なる内部層 11を、先端部14 aを含めて全体に白金族 30 元素の金属、例えば白金Ptで被覆して第二被覆層15 が形成されている。ととで、白金Ptは、導電性はAu より劣るが、硬度が高く酸化しにくいので、端子2のA uが付着する粘着現象を確実に防ぐことができる。尚、 第二被覆層15に用いる白金族元素の金属として、白金 Pt以外に、Ru、Ph、Pd、Os、Ir等を採用す るととができる。

【0016】次に第二の実施の形態の変形例を図3により説明する。図3において、コンタクトピン16は、Ni-Mn合金からなる内部層11を、先端部16aを含40めて全体に白金族の金属、例えば白金Ptで被覆して第二被覆層15が形成されている点で、第二の実施の形態によるコンタクトピン14と等しい。本変形例では、更に第二被覆層15の表面に、端子2との通電用接触部である先端部16aを除いた部分に導電性金属としてAuが被覆されて第三被覆層18が形成されている。この構成によれば、第二の実施の形態の効果に加えて、第二被覆層15の導電性がAuより劣っていても、端子2から先端部16aに伝送された信号は表皮効果によって導電性のよいAuからなる第三被覆層18を伝送されるか50

ら、信号の劣化によるノイズの発生を確実に防止できる という作用効果を奏する。

【0017】次に本発明の第三の実施の形態を図4により説明する。図4において、コンタクトピン20は、Ni-Mn合金からなる内部層11が、先端部11aを除いてAuからなる第四被覆層22で被覆されている。しかもコンタクトピン20の先端部20aでは、内部層11の先端11aが白金族の金属、例えば白金Ptで被覆されて第五被覆層24が形成されている。本実施の形態によれば、コンタクトピン20の先端部20aが白金Ptの第五被覆層24で被覆されているから、端子2のAuが粘着現象でコンタクトピン20の先端部20aに付着することはなく、しかも先端部20aを除いては内部層11の表面がAuの第四被覆層22で覆われているから、信号の劣化を確実に防止できる。

【0018】尚、Ni-Mn合金からなる内部層11e被覆する第一被覆層12,第三被覆層18,第四被覆層22e、Auに代えてAg、Cu等のいずれかの材質で構成しても良い。また、端子20の材質についても、Auに代えてはんだ(Pb-Sn)を用いてもよい

[0019]

【発明の効果】上述のように、本発明に係るコンタクトプローブでは、コンタクトピンの針先は、Ni基合金からなる内部層が通電用接触部を除いて導電性金属で被覆されているから、半導体ICチップなどの被検査物の金やはんだ等の端子にコンタクトピンの通電用接触部を接触させると、通電用接触部では異種金属の接触となり、しかもNi基合金は硬度が高いために端子の金属が付着する粘着現象を防止できる。しかもコンタクトピンは、通電用接触部以外の部分がAu等の導電性金属で被覆されているから導電性が良く、しかも表皮効果を利用できるために信号が劣化することなく伝送され、高周波対応も可能である。

[0020] また本発明に係るコンタクトブローブでは、コンタクトビンの針先は、Ni基合金からなる内部層が白金族元素の金属で被覆されているから、通電用接触部の酸化による接触不良が起こらず、しかも白金族の金属は金やはんだ等の端子と異種金属で硬度が高いので粘着現象が生じない。また、白金族の金属の表面は、通電用接触部を除いて導電性金属で被覆されていてもよく、通電用接触部に粘着現象が生じない上に、表皮効果によって信号が劣化することなく伝送されるという効果を奏する。

【0021】また本発明に係るコンタクトブローブでは、コンタクトピンの針先が、Ni基合金からなる内部層のうち、通電用接触部が白金族元素の金属で被覆され、その他の部分はAu等の導電性金属で被覆されているから、通電用接触部に粘着現象が生じず、表皮効果によって信号が劣化することなく伝送される。

50 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第一の実施の形態によるコンタクト プローブのコンタクトビンの針先部分の縦断面と半導体 ICチップを示す概略説明図である。

[図2] 本発明の第二の実施の形態によるコンタクト ピンの針先部分の縦断面図である。

[図3] 第二の実施の形態の変形例を示すコンタクト ピンの針先部分の縦断面図である。

【図4】 本発明の第三の実施の形態によるコンタクト ピンの針先部分の縦断面図である。

【図5】 従来のコンタクトブローブの概略平面図であ 10 11 内部層 る。

【図6】 図5に示すコンタクトブローブのコンタクト ビンの部分の一部縦断面図である。

【図7】 図5及び図6に示すコンタクトブローブを装 着したプローブカードの分解斜視図である。

【図8】 図7に示すプローブカードのコンタクトプロ*

* ーブを装着した状態を示す縦断面図である。

【図9】 従来のコンタクトピンの縦断面と半導体 [C チップを示す概略説明図である。

【図10】 隣接するコンタクトピンの針先間の金付着 状態を示す図である。

【符号の説明】

2 端子

10, 14, 16, 20 コンタクトピン

10a, 16a, 20a 先端部

12 第一被覆層

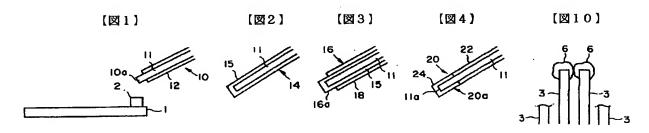
15 第二被覆層

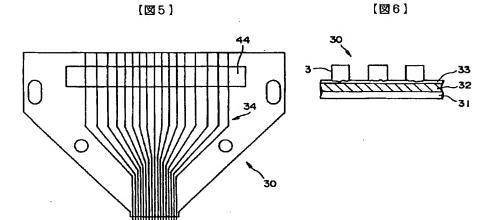
18 第三被覆層

22 第四被覆層

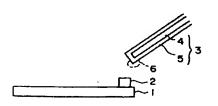
24 第五被覆層

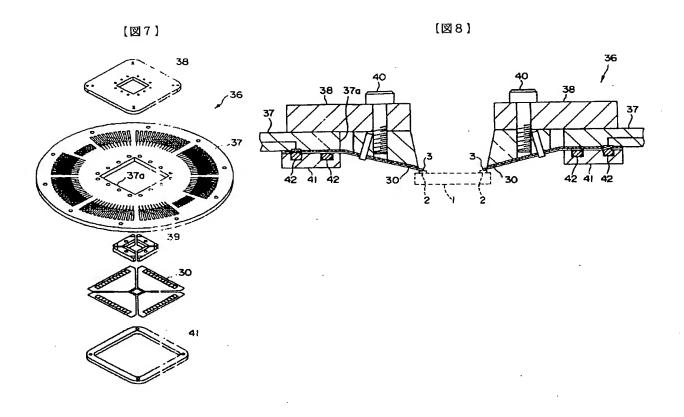
30 コンタクトプローブ





【図9】





フロントページの続き

(72)発明者 石井 利昇 兵庫県三田市テクノバーク十二番の六 三 菱マテリアル株式会社三田工場内